





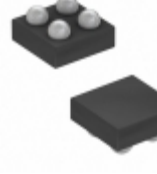


	<h2>SI8808DB-T2-E1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8808DB-T2-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V MICROFOOT</p> <p>Datenblätter:  SI8808DB-T2-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2202 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8808DB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2202 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	46 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 500mW (Ta) Surface Mount 4-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-UFPGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	95 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	330pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI8808DB-T2-E1TR

SI8808DB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8808DB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8808DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8808DB-T2-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8806DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V MICROFOOT</p>	 <p>SI8806DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V MICROFOOT</p>	 <p>SI8805EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V MICROFOOT</p>	 <p>SI8810EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT</p>
 <p>SI8809EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.9A MICROFOOT</p>	 <p>SI8808DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V MICROFOOT</p>	 <p>SI8802DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V MICROFOOT</p>	 <p>SI8810EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 2.1A MICROFOOT</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI8640EC-B-IS	↔ SI8640ED-B-IS	⇒ SI8641BB-B-IS	D SI8641BC-B-IS	↔ SI8641BD-A-ISR
⊖ SI8641BD-B-IS	⊕ SI8641BD-B-ISR	D SI8641EC-B-IS	⇒ SI8641ED-B-IS	↔ SI8641ED-B-ISR
⊕ SI8642AB-B-ISR	⊖ SI8642BC-B-IS1	⊕ SI8645BB-B-IS	↔ SI8645BC-B-IS	↔ SI8645BD-B-IS
D SI8660AB-B-IS1	⊕ SI8660BA-A-IS1R	⊖ SI8661BD-B-ISR	⊕ SI8662AB-B-IS1	↔ SI8662BC-A-IS1R
⇒ SI8710AC-B-IS	↔ SI8710AD-B-IS	⊕ SI8710BD	⊖ SI8710CC-B-IP	↔ SI8710CC-B-IS
↔ SI8710CD-B-IS	⇒ SI8710CD-B-ISR	D SI8711CC-B-IS	⊕ SI8712AC-B-IS	⊖ SI8716BC
⊕ SI8716BC-A-IS	D SI8719BD-A-IS	⇒ SI8800EDB-T2-E1	↔ SI8800EDB-T2-E1	↔ SI8802DB-T2-E1
⊖ SI8802DB-T2-E1	⊕ SI8808DB-T2-E1	↔ SI8812DB-T2-E1	⇒ SI8812DB-T2-E1	↔ SI8901EDB-T2
⊕ SI8901EDB-T2-E1	⊖ SI8901EDB-T2-E1	⊕ SI8902EDB	D SI8902EDB-T2	↔ SI8902EDB-T2-E
↔ SI8902EDB-T2-E1	⊕ SI8902EDB-T2-E1	⊖ SI8920AC-IP	⊕ SI8920BC-IPR	↔ SI8920BC-IPR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

